

Rys. 1-535. BF245

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: SESCOSEM

Wykonanie: tranzystor krzemowy polowy (kanał N) epitaksjalno-planarny w obudowie plastikowej

Zastosowanie: wzmacniacze o małych szumach i dużej impedancji wejściowej w zakresie od prądu stałego do VHF, czopery

Wartości charakterystyczne<sup>1)</sup>

	min	typ	max		
$U_{(BR)GS}$	-30			V	przy $I_G = -1 \mu A, U_{DS} = 0$
$I_{GSS}$			-5	nA	przy $U_{GS} = -20 V, U_{DS} = 0$
$I_{DSS}^{2)3)}$	2		25	mA	przy $U_{DS} = 15 V, U_{GS} = 0$
$U_{GSY}^{3)}$	-0,4		-7,5	V	przy $U_{DS} = 15 V, I_D = 200 \mu A$
$U_{GSX}$	-0,5		-8	V	przy $U_{DS} = 15 V, I_D = 10 nA$
$ y_{21S} $	3	5,5	6,5	mS	przy $U_{DS} = 15 V, U_{GS} = 0, f = 1 kHz$
$C_{12SS}$		1,1		pF	przy $U_{DS} = 20 V, U_{GS} = -1 V, f = 1 MHz$
$C_{11SS}$		4		pF	przy $U_{DS} = 20 V, U_{GS} = -1 V, f = 1 MHz$
$C_{22SS}$		1,6		pF	przy $U_{DS} = 20 V, U_{GS} = -1 V, f = 1 MHz$
$g_{11S}$		70		$\mu S$	przy $U_{DS} = 20 V, U_{GS} = -1 V, f = 100 MHz$
$g_{11S}$		250		$\mu S$	przy $U_{DS} = 20 V, U_{GS} = -1 V, f = 200 MHz$

Wartości graniczne<sup>1)</sup>

$U_{DG} \max$	30	V	$P_{tot} \max$	360 <sup>4)</sup>	mW
$U_{DS} \max$	$\pm 30$	V	$t_{stg}$	$+55 \div +150$	$^{\circ}C$
$I_G \max$	10	mA			

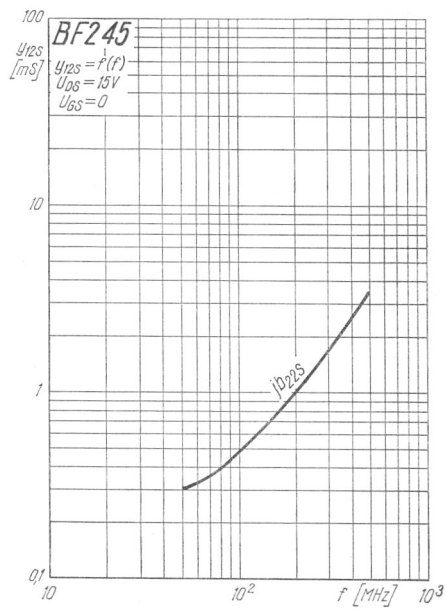
<sup>1)</sup>  $t_{amb} = 25^{\circ}C$

<sup>2)</sup> pomiar impulsem  $t_p \leq 300 \mu s, \delta \leq 2\%$

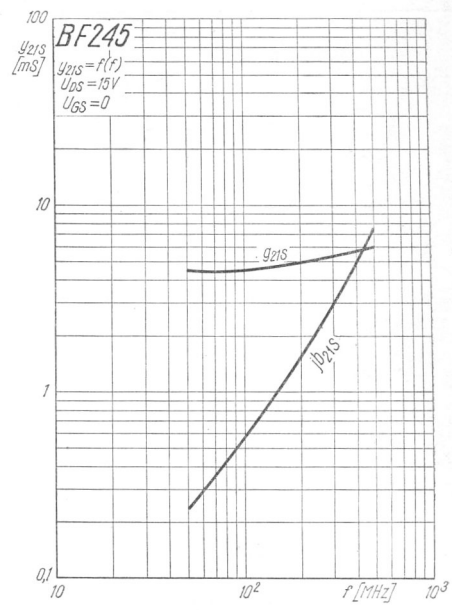
<sup>3)</sup> wykonanie w 3 grupach A, B i C

<sup>4)</sup>  $t_{case} = 25^{\circ}C$

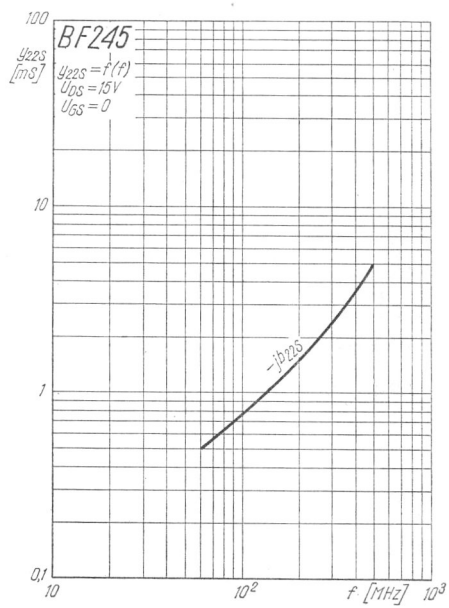
	$I_{OSS}$	$U_{GSY}$
A	$2 \div 6,5 mA$	$-0,4 \div -2,2 V$
B	$6 \div 15 mA$	$-1,6 \div -3,8 V$
C	$12 \div 25 mA$	$-3,2 \div -7,5 V$



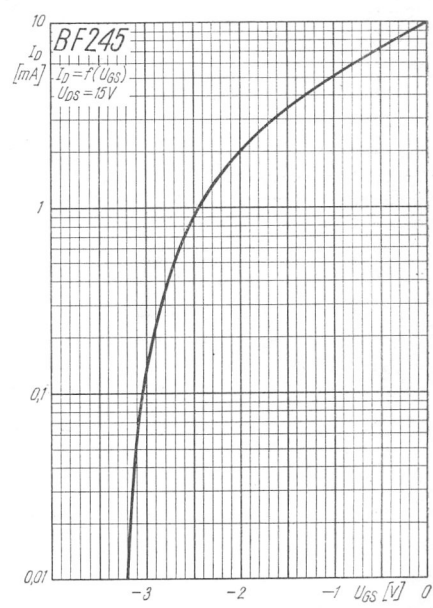
Rys. 1-536. Zależność admittancji zwrotnej od częstotliwości



Rys. 1-537. Zależność admittancji przejściowej od częstotliwości



Rys. 1-538. Zależność admittancji wyjściowej od częstotliwości



Rys. 1-539. Charakterystyka przejściowa

